

**DYREKTOR  
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE  
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO  
ADIUNKTA  
w Zakładzie Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych**

**Zakres wykonywanych zadań:**

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie się zajmowała badaniami naukowymi w dziedzinie obróbki technologicznej struktur półprzewodnikowych III-V, II-VI i IV-IV dla mikroelektroniki, optoelektroniki i czujników biochemicznych. Prace badawcze będą wykonywane w Zakładzie Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej w ww. zakładzie będzie należało:

- opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, a w oparciu o nie nowych przyrządów i podzespołów z materiałów półprzewodnikowych III-V, II-VI i IV-IV;
- pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie badań poprzez aplikowanie o projekty i realizacje usług naukowych;
- realizację badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym w ramach współpracy międzynarodowej, na wysokim poziomie naukowym, potwierdzonym publikacjami w renomowanych czasopiśmie naukowych i/lub patentami.

**Oczekiwania wobec kandydata:**

- stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki lub inżynierii materiałów;
- predyspozycje do pracy eksperymentalnej;
- znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i obróbką technologiczną struktur półprzewodnikowych III-V, II-VI i IV-IV dla przyrządów mikroelektronicznych, optoelektronicznych i czujników biochemicznych;
- doświadczenie pracy w laboratorium technologicznym o podwyższonej klasie czystości;
- dobra znajomość technik fotolitografii wysokorozdzielczej i mikroskopii sił atomowych;
- praktyczna znajomość zagadnień związanych z fizykochemią powierzchni półprzewodnikowych;
- znajomość zagadnień związanych z niezawodnością struktur i mikrosystemów;
- umiejętność budowy systemów i stanowisk pomiarowych;
- umiejętność korzystania z oprogramowania Delphi, Visual Basic, C i C++, CAD Ansys, Eagle, Protel, Statgraphics, Microsoft Office, Lotus Notes oraz doświadczenie w rozwijaniu oprogramowania;
- doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym;
- doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w tym w zarządzaniu budżetem;
- doświadczenie w pracy w środowisku przemysłowym;
- doświadczenie w publicznych prezentacjach, skierowanych do ekspertów i do zwykłych odbiorców (seminaria, konferencje naukowe, zajęcia dydaktyczne, szkolenia);
- umiejętność pracy w zespole jak również samodzielnie;
- umiejętności przywódcze;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; podstawowa znajomość drugiego języka obcego.

Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w pracy w zagranicznych instytucjach naukowych i przemysłowych sektora elektronicznego.

**Wymagane dokumenty:**

- podanie,
- życiorys,
- dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych,
- dyplom (odpis, zaświadczenie) uzyskania stopnia doktora,
- kserokopia dokumentu tożsamości,
- spis osiągnięć naukowo-badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji, patentów i udziału w projektach naukowo-badawczych,
- opinia dwóch pracowników naukowych posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu.

Kandydatów do pracy na to stanowisko prosi się o parafowanie każdej strony składanych dokumentów.

**Tryb i termin składania ofert:**

Wyżej wymienione dokumenty prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych ITE (02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, blok VI, pok. 215) do dnia **23 lutego 2012 r.**

Pragniemy poinformować kandydatów, że komisja konkursowa może poprosić ich o publiczne przedstawienie wyników swoich prac naukowych w formie seminarium.

**Rozstrzygnięcie konkursu:**

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia **8 marca 2012 r.**